

PNP SILICON LOW POWER TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/350

DEVICES

2N3867 **2N3867S**
2N3868 **2N3868S**

LEVELS
JAN
JANTX
JANTXV
JANS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	2N3867	2N3868	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	40	60	Vdc
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	40	60	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	4.0		Vdc
Collector Current	I_C	3.0		mAdc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}$ ⁽¹⁾	P_T	1.0		W/°C
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-65 to +200		°C

THERMAL CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	175	°C/mW

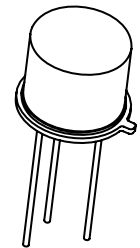
Note: * Electrical characteristics for “S” suffix devices are identical to the “non S” corresponding devices.

1/ Derate linearly 5.71mW/°C for $T_A > +25^\circ\text{C}$

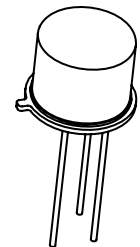
2/ Derate linearly 57.1mW/°C for $T_C > +25^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Breakdown Current $I_C = 10\mu\text{Adc}$	$V_{(BR)CEO}$	40	60	Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 40\text{Vdc}$ $V_{CB} = 60\text{Vdc}$	I_{CBO}		100	μAdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 4.0\text{Vdc}$	I_{EBO}		100	μAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 40\text{Vdc}$ $V_{CE} = 60\text{Vdc}$ $V_{CE} = 40\text{Vdc}, T_A = +150^\circ\text{C}$ $V_{CE} = 60\text{Vdc}, T_A = +150^\circ\text{C}$	I_{CEX}		1.0 1.0 50 50	μAdc



TO-5 *
2N3867, 2N3868



TO-39 * (TP-205AD)
2N3867S, 2N3868S

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = +25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted) (CONT.)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS ⁽²⁾				
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 500\text{mA}$, $V_{CE} = 1.0\text{Vdc}$ 2N3867, S 2N3868, S	h_{FE}	50		
$I_C = 1.5\text{A}$, $V_{CE} = 2.0\text{Vdc}$ 2N3867, S 2N3868, S		35	200	
$I_C = 2.5\text{A}$, $V_{CE} = 3.0\text{Vdc}$ 2N3867, S 2N3868, S		40	150	
$I_C = 3.0\text{A}$, $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$ 2N3867, S 2N3868, S		30		
$I_C = 500\text{mA}$, $V_{CE} = 1.0\text{Vdc}$, $T_A = -55^\circ\text{C}$ 2N3867, S 2N3868, S		25		
$I_C = 500\text{mA}$, $V_{CE} = 1.0\text{Vdc}$, $T_A = -55^\circ\text{C}$ 2N3867, S 2N3868, S		20		
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 500\text{mA}$, $I_B = 50\text{mA}$ $I_C = 1.5\text{A}$, $I_B = 150\text{mA}$ $I_C = 2.5\text{A}$, $I_B = 250\text{mA}$	$V_{CE(sat)}$		0.5 0.75 1.5	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 500\text{mA}$, $I_B = 50\text{mA}$ $I_C = 1.5\text{A}$, $I_B = 150\text{mA}$ $I_C = 2.5\text{A}$, $I_B = 250\text{mA}$	$V_{BE(sat)}$	0.9 0.85	1.0 1.4 1.4 2.0	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short Circuit Forward Current Transfer Ratio $I_C = 100\text{mA}$, $V_{CE} = 5.0\text{Vdc}$, $f = 20\text{MHz}$	$ h_{fc} $	3	12	k Ω
Output Capacitance $V_{CB} = 10\text{Vdc}$, $I_E = 0$, $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	C_{obo}		120	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 3.0\text{Vdc}$, $I_C = 0$, $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	C_{ibo}		800	pF

(2) Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2.0\%$

SWITCHING CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Delay Time Rise Time $V_{CC} = -30\text{dc}, V_{EB} = 0$ $I_C = 1.5\text{Adc}, I_{B1} = 150\text{mAdc}$	t_d t_r		35 65	nS
Storage Time Fall Time $V_{CC} = -30\text{dc}, V_{EB} = 0$ $I_C = 1.5\text{Adc}, I_{B1} = I_{B2} = 150\text{mAdc}$	t_s t_f		500 100	nS
Turn-On Time $V_{CC} = 30, I_C = 1.5\text{Adc}, I_B = 150\text{mA}$	t_{on}		100	nS
Turn-Off Time $V_{CC} = 30, I_C = 1.5\text{Adc}, I_B = 150\text{mA}$	t_{off}		600	nS

SAFE OPERATING AREA

DC Test

$T_C = 25^\circ\text{C}, 1 \text{ cycle}, t = 1.0\text{s}$

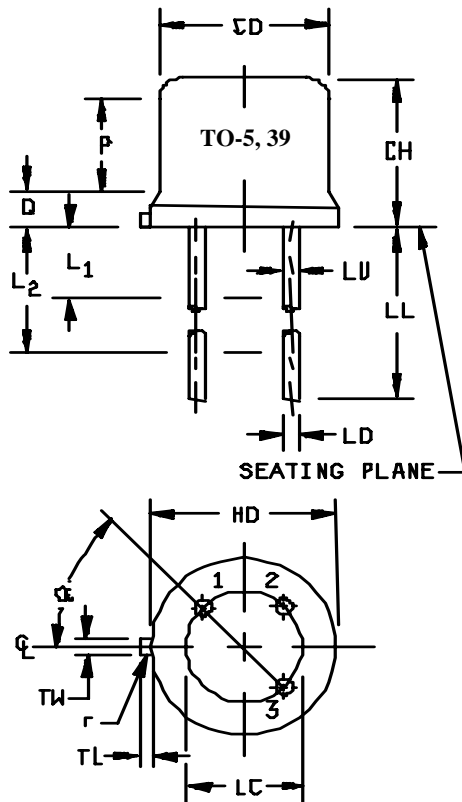
Test 1

$V_{CE} = 3.33\text{Vdc}, I_C = 3.0\text{Adc}$

Test 2

$V_{CE} = 40\text{Vdc}, I_C = 160\text{mAdc}$ 2N3867,
 $V_{CE} = 60\text{Vdc}, I_C = 80\text{mAdc}$ 2N3868, S

PACKAGE DIMENSIONS



Symbol	Dimensions				Note
	Inches		Millimeters		
	Min	Max	Min	Max	
CD	.305	.335	7.75	8.51	5, 6
CH	.240	.260	6.10	6.60	
HD	.335	.370	8.51	9.40	4, 5
LC	.200 TP		5.08 TP		7
LD	.016	.019	0.41	0.48	8,9
LL	See note 8, 14				
LU	.016	.019	0.41	0.48	8,9
L ₁		.050		1.27	8,9
L ₂	.250		6.35		8,9
P	.100		2.54		7
Q		.030		0.76	5
TL	.029	.045	0.74	1.14	3,4
TW	.028	.034	0.71	0.86	3
R		.010		0.25	10
α	45° TP		45° TP		7
1, 2, 10, 12, 13, 14					

NOTES:

- Dimensions are in inches.
- Millimeters are given for general information only.
- Beyond r (radius) maximum, TW shall be held for a minimum length of .011 (0.28 mm).
- Dimension TL measured from maximum HD.
- Body contour optional within zone defined by HD, CD, and Q.
- CD shall not vary more than .010 inch (0.25 mm) in zone P. This zone is controlled for automatic handling.
- Leads at gauge plane .054 +.001 -.000 inch (1.37 +0.03 -.000 mm) below seating plane shall be within .007 inch (0.18 mm) radius of true position (TP) at maximum material condition (MMC) relative to tab at MMC. The device may be measured by direct methods or by gauging procedure.
- Dimension LU applies between L₁ and L₂. Dimension LD applies between L₂ and LL minimum. Diameter is uncontrolled in and beyond LL minimum.
- All three leads.
- The collector shall be internally connected to the case.
- Dimension r (radius) applies to both inside corners of tab.
- In accordance with ASME Y14.5M, diameters are equivalent to φx symbology.
- Lead 1 = emitter, lead 2 = base, lead 3 = collector.
- For non-S-suffix devices (TO-5), dimension LL = 1.5 inches (38.10 mm) min. and 1.75 inches (44.45 mm) max. For S-suffix types (TO-39), dimension LL = .5 inch (12.70 mm) min. and .750 inch (19.05 mm) max.

FIGURE 1. Physical dimensions (similar to TO-5, TO-39)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331